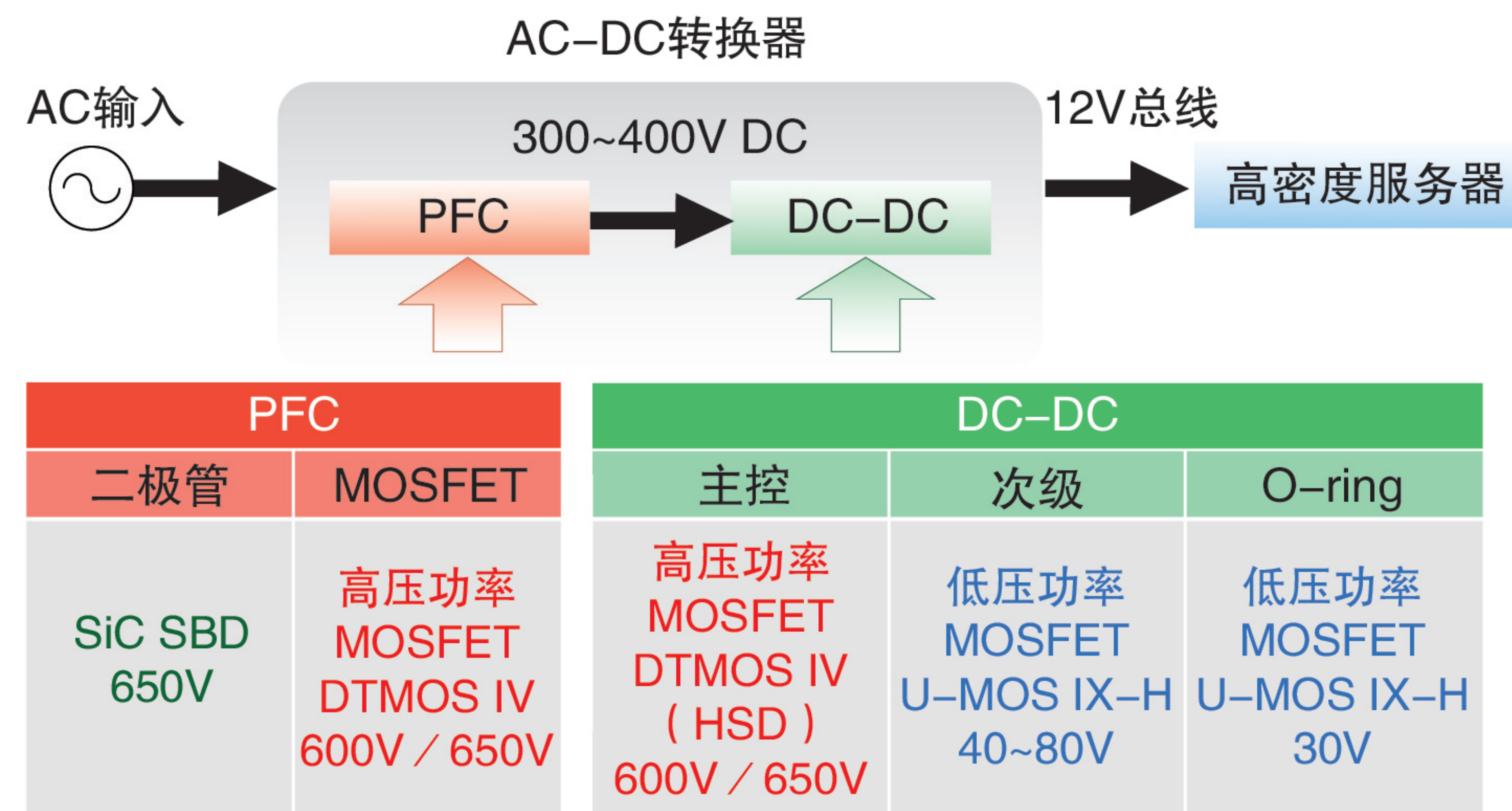


用于开关电源的功率MOSFET & SiC SBD

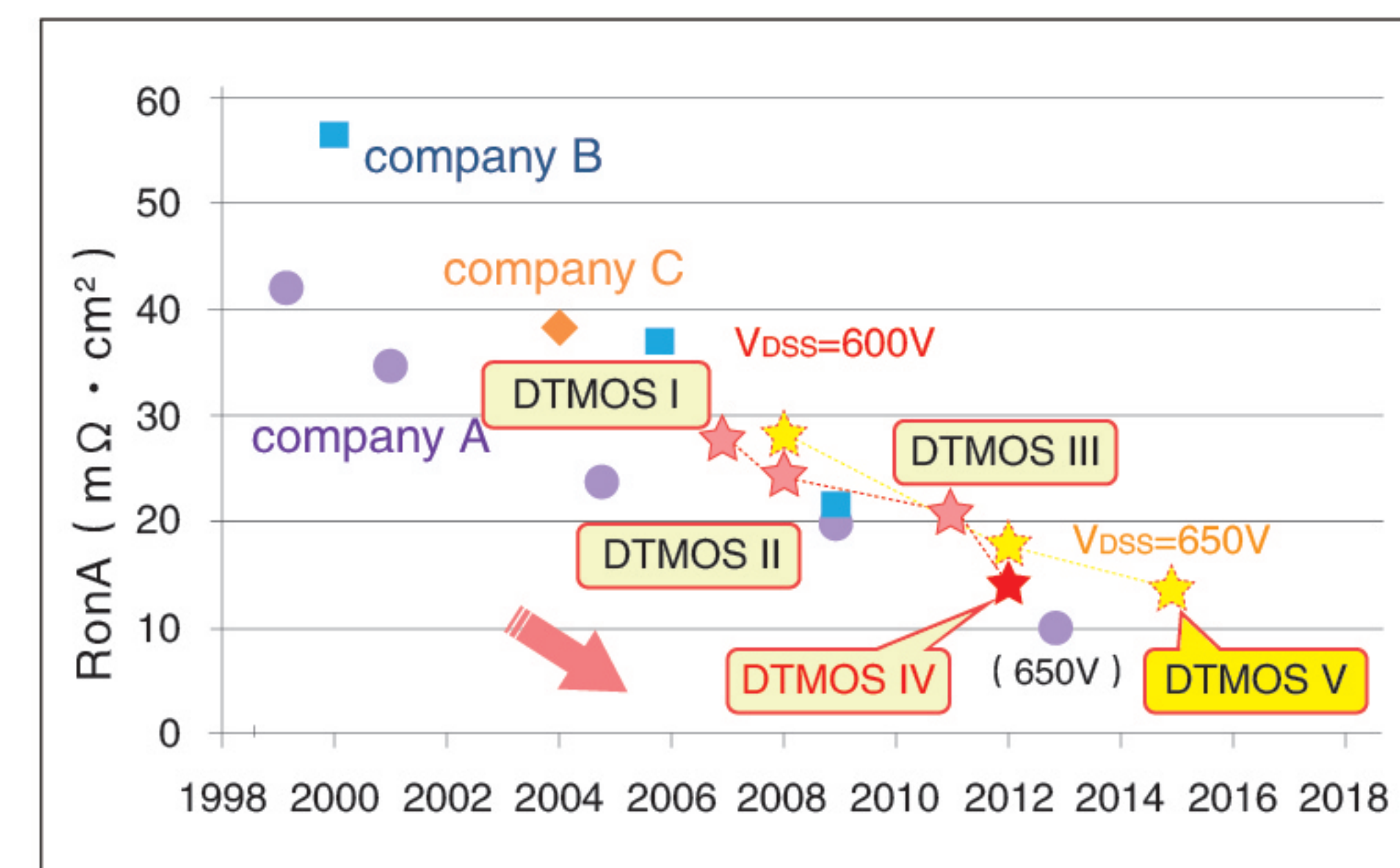
采用东芝最新工艺技术的功率器件，可提高开关电源的效率

开关电源系统的结构及建议（适用于服务器）



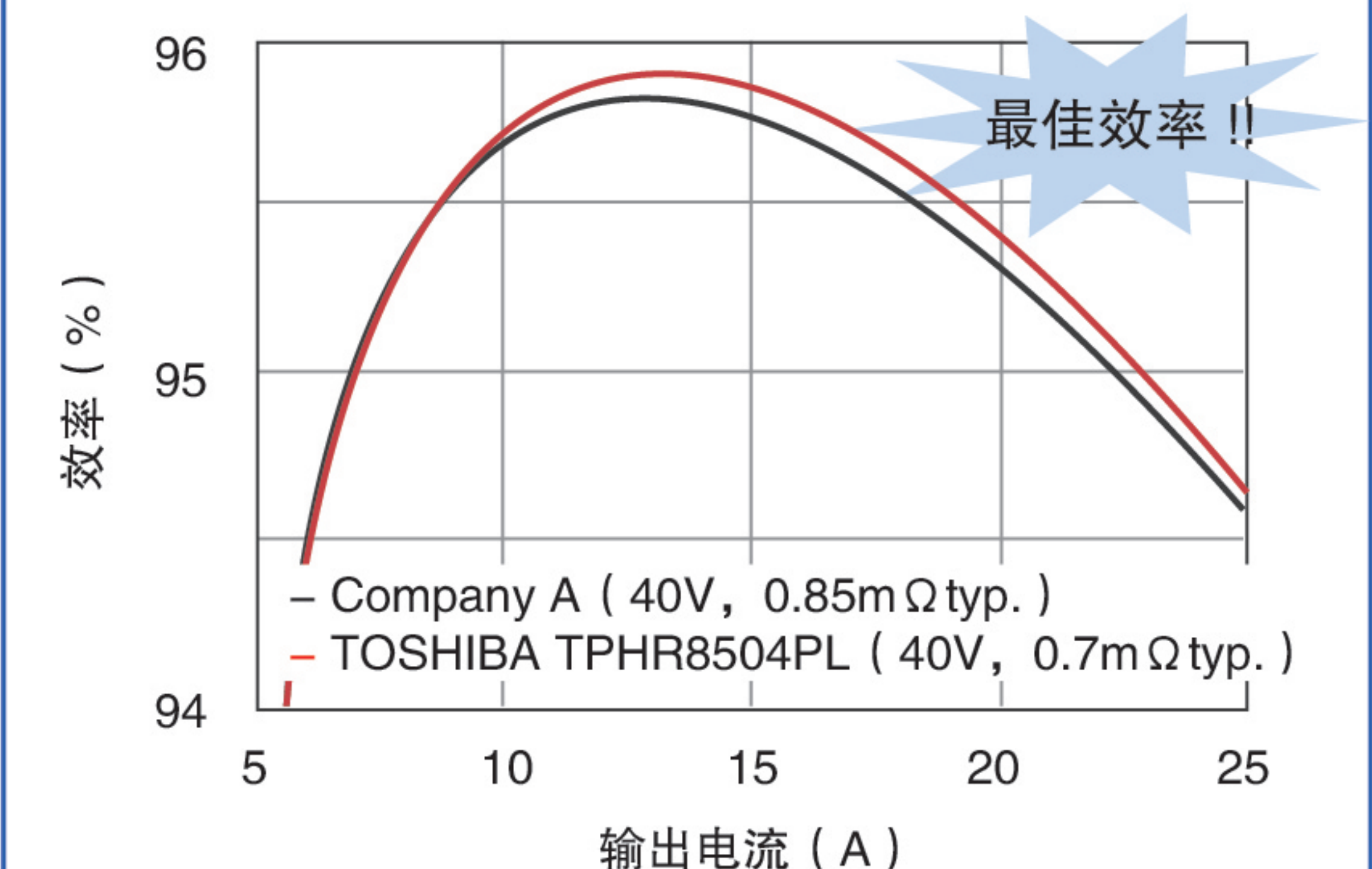
DTMOSIV ($V_{DS}=600\sim650V$)

- > 因采用单层外延技术而具有最佳的 $R_{on}\cdot A$ 和更好的温度系数
- > 因较小的 C_{oss} 而具有更好的轻负载效率
- > 带快恢二极管的系列产品



U-MOSIX-H ($V_{DS}=30\sim100V$)

- TPHR8504PL (Nch 40V)
- > 最佳的 $R_{DS(ON)}$:
0.7mΩ 典型值 @ $V_{GS}=10V$
 - > 低的 $Q_{oss}\cdot R_{on}$ 特征:
60nC·mΩ @ $V_{DS}=20V$

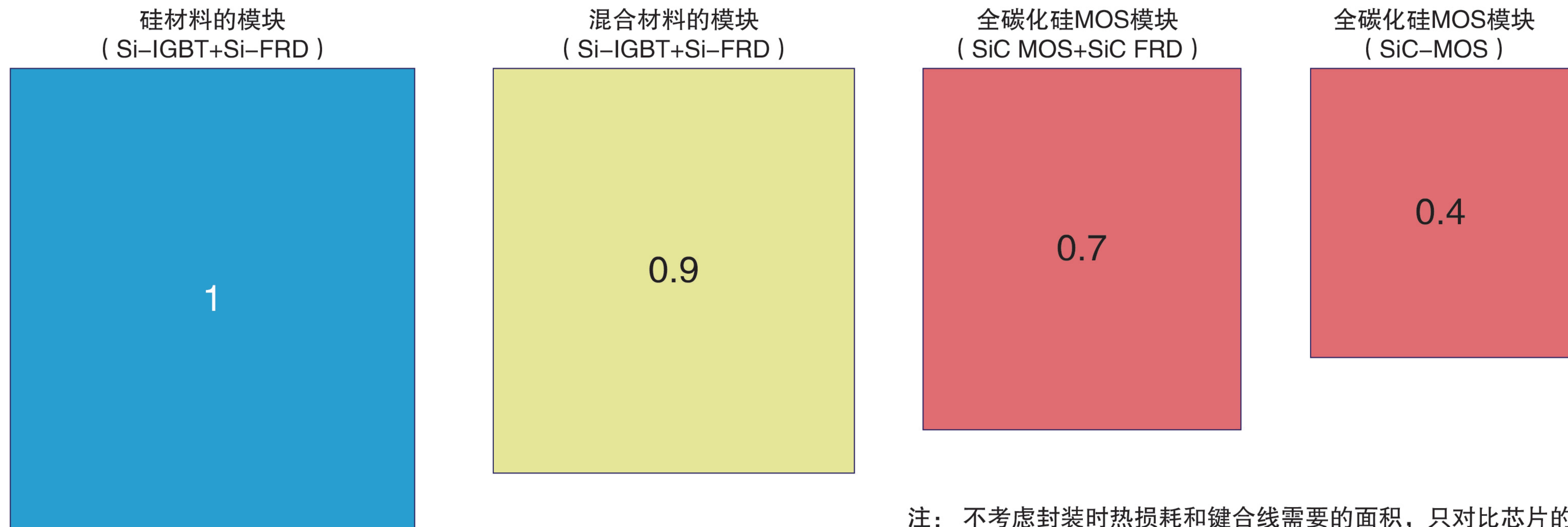


SiC-MOSFET功率模块的研发

研发小型化、高性能的功率模块

■ 我们在基于相同的电流能力下，比较了用Si材料和SiC材料时芯片的面积

[设定1700V-400A Si IEGT模块芯片面积为“1”]



注： 不考虑封装时热损耗和键合线需要的面积，只对比芯片的面积。